

## 상압소결에 의해 제조한 자체 강인화 질화규소 세라믹의 미세조직과 기계적 성질

김완중 · 이영규 · 조원승 · 최상욱

인하대학교 무기재료공학과

(1999년 2월 5일 접수)

## Microstructure and Mechanical Properties of Self-Reinforced $\text{Si}_3\text{N}_4$ Ceramic Prepared by Pressureless-Sintering

Wan Jung Kim, Young Gue Lee, Won Seung Cho and Sang Wook Choi

Department of Ceramic Engineering, Inha University, Incheon 402-751, Korea

(Received February 5, 1999)

### 초 록

$\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$  휘스커를 종자로 첨가한 자체 강인화  $\text{Si}_3\text{N}_4$  세라믹스를 상압소결에 의해 제조하였고,  $\text{Si}_3\text{N}_4$  세라믹의 미세조직, 기계적 성질 및  $\alpha \rightarrow \beta$  상전이에 미치는  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$  휘스커의 영향을 조사하였다. 자체 강인화  $\text{Si}_3\text{N}_4$  세라믹스는, 소결조제로서 8 mol%  $\text{Y}_2\text{O}_3$ 와 6 mol%  $\text{Al}_2\text{O}_3$ 을 사용하고, 2시간 불밀링한  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$  휘스커를 5 vol% 종자로 첨가하여 소결(1800°C, 2시간)함으로써, 98% 이상으로 치밀화 되었다. 자체 강인화  $\text{Si}_3\text{N}_4$  세라믹의 파괴인성은  $\text{Si}_3\text{N}_4$  monolith의 5.4  $\text{MPa} \cdot \text{m}^{1/2}$ 에 비해 7.8  $\text{MPa} \cdot \text{m}^{1/2}$ 로 비교적 높은 값을 보였다. 자체 강인화  $\text{Si}_3\text{N}_4$  세라믹내의  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4(w)$ 는 침상의 형상이므로 액상소결의 초기단계에서 치밀화를 방해하나,  $\alpha \rightarrow \beta$  상전이시  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4(w)$ 가 핵으로 작용하여 상전이를 촉진시키며, 그 촉진효과는 핵의 수가 많을수록 증대되었다.

### ABSTRACT

The self-reinforced  $\text{Si}_3\text{N}_4$  ceramics were prepared by pressureless-sintering using  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$  whiskers as a seed. Effects of  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$  whiskers on microstructure and mechanical properties, and the  $\alpha$  to  $\beta$  phase transition of  $\text{Si}_3\text{N}_4$  were investigated. The self-reinforced  $\text{Si}_3\text{N}_4$  ceramics were densified (relative density  $\geq 98\%$ ) by pressureless-sintering (1800°C, 2h) using 8mol%  $\text{Y}_2\text{O}_3$  and 6mol%  $\text{Al}_2\text{O}_3$  as sintering aids and 5 vol%  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$  whiskers (ball-milled for 2h) as a seed. The fracture toughness of self-reinforced  $\text{Si}_3\text{N}_4$  ceramic showed relatively higher value of 7.8  $\text{MPa} \cdot \text{m}^{1/2}$  than 5.4  $\text{MPa} \cdot \text{m}^{1/2}$  of the  $\text{Si}_3\text{N}_4$  monolith. During the initial stage of liquid-phase sintering,  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$  whiskers within self-reinforced  $\text{Si}_3\text{N}_4$  ceramic seemed to hinder the densification owing to their acicular shapes, but accelerated the  $\alpha$  to  $\beta$  phase transition because they acted as pre-existing nuclei. It was found that the more  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$  nuclei, the faster  $\alpha$  to  $\beta$  phase transition.

**Key words :** Pressureless-sintering, Self-reinforced silicon nitride, Microstructure, Fracture toughness, Phase transition

### 1. 서 론

질화규소( $\text{Si}_3\text{N}_4$ ) 세라믹은 우수한 열적·기계적 성질을 갖고 있기 때문에 고온 구조용재료로서 가장 기대되고 있는 재료이며, 현재 자동차의 엔진부품, 베어링 등의 각종 분야에 응용되고 있다. 그러나, 향후 그 응용분야를 더욱 확대시키기 위해서는 파괴인성의 향상이 요구된다.

$\text{Si}_3\text{N}_4$ 의 파괴인성을 향상시키기 위한 방법의 하나로써, 본 저자들은 미세한  $\text{Si}_3\text{N}_4$  매트릭스내에 침상의 조대한  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$  휘스커(이후,  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4(w)$ 로 생략)를 분산시키는 미세구조 제어를 통하여 제조한 자체 강인화(in-situ or

self-reinforced)  $\text{Si}_3\text{N}_4$ 에 대하여, 그 기계적 성질과 미세구조를 체계적으로 조사한 바 있다.<sup>1,2)</sup> 그 결과에 의하면, 종자(seed)로 첨가한  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4(w)$ 가 조대한  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$  결정립으로 성장하였고, 이 조대한 휘스커상의  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$  결정립들에 의해 균열의 편향(crack deflection),<sup>3)</sup> 입자가교(grain bridging),<sup>4)</sup> pull-out<sup>5)</sup>등의 고인성화기구가 활발히 일어나 파괴인성이 향상됨을 밝혔다. 그러나, 본 저자들이 이전에 발표한 자체 강인화  $\text{Si}_3\text{N}_4$  세라믹은 열간가압(hot-press) 소결법을 사용하여 제조한 것으로, 이 열간가압법은 제조 단가가 높고, 실제 형상에 기까운(near-net shape) 제품의 제조가 곤란하다는 등의 문제점이 있다. 한편, 타 연구결

과를 살펴보면, 자체 강인화  $\text{Si}_3\text{N}_4$ 의 제조방법에 있어서 주로 열간가압법 혹은 가스압 소결법을 이용하고 있으나,<sup>6,7)</sup> 상압소결에 의해 제조한 자체 강인화  $\text{Si}_3\text{N}_4$ 에 관한 연구는 거의 보고되고 있지 않다.

따라서, 본 연구에서는 열간가압 소결법에 비해 제조단계가 간단한 상압소결법을 이용하여, 고인성의 자체 강인화  $\text{Si}_3\text{N}_4$  세라믹을 제조하는 조건을 탐색하고자, 상압소결 치밀화도에 미치는 소결온도 및 시간, 소결조제의 첨가량,  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$  휘스커의 첨가량과 형상비(aspect ratio)의 영향을 조사하였다. 그리고, 최적조건하에서 제조한 자체 강인화  $\text{Si}_3\text{N}_4$  세라믹의 기계적 특성과  $\text{Si}_3\text{N}_4$  결정립도, 균열편향, 파단면 등의 미세조직을 조사하여, 고인성  $\text{Si}_3\text{N}_4$  세라믹스의 경제적 제조법을 제시하고자 하였다.

## 2. 실험방법

### 2.1. 시편제조

원료분말로는  $\alpha\text{-Si}_3\text{N}_4$ ( $\alpha$ -phase>95%, 평균 입자 크기: 0.17  $\mu\text{m}$ , E-10, Ube Kosan사, 일본)를 사용하였고, 소결조제로는  $\text{Y}_2\text{O}_3$ (순도: >99.5%, 평균 입자 크기: 0.25  $\mu\text{m}$ , Shinetsu Chemical사, 일본)와  $\text{Al}_2\text{O}_3$ (순도: >99.99%, 평균 입자 크기: 0.39  $\mu\text{m}$ , Sumitomo Chemical사, 일본)를 사용하였다. 그리고 첨가 휘스커로는  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$ (평균 직경: 0.5  $\mu\text{m}$ , 길이: 2.5~5  $\mu\text{m}$ , Ube Kosan사, 일본)를 사용하였다.

$\alpha\text{-Si}_3\text{N}_4$  원료분말에 소결조제로서 4mol%  $\text{Y}_2\text{O}_3$ -3mol%  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ( $\circ$ )후, 4Y-3A로 생략하여 표기)와 8mol%  $\text{Y}_2\text{O}_3$ -6mol%  $\text{Al}_2\text{O}_3$ (8Y-6A)를 첨가하고, 결합제(Camphor)를 소량 첨가한 후 M.C. 나일론 pot(0.4 l)에서 70시간 동안  $\text{Si}_3\text{N}_4$  볼( $\Phi$ 10 mm, 250개)을 사용하여 에틸 알콜중에서 습식 밀링하였다. 이후 초음파 분산과 교반기(560 rpm, 20분)를 동시에 사용하여  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$ (w)를 매트릭스 분말에 5~20 vol% 첨가·분산시킨 후 M.C. 나일론 pot에서 2시간 동안 에틸 알콜중에서 습식 밀링하였다. 이때 불밀링에 의한 휘스커의 기계적 손상을 최소화하기 위하여  $\text{Si}_3\text{N}_4$  볼의 수를 125개로 줄여서 사용하였다. 그리고 비교용 시료로써 휘스커를 첨가하지 않은  $\text{Si}_3\text{N}_4$  분말과  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$ (w)를 원료분말과 함께 첨가한 후 72시간 동안 같은 조건에서 불밀링( $\text{Si}_3\text{N}_4$  볼의 수는 250개)하였다. 혼합분말내의 휘스커의 형상비는 불밀링시간이 길어짐에 따라 작아졌으나, 72시간후에도 침상의 휘스커가 잔류하고 있음을 주사전자현미경(SEM)관찰을 통해 확인하였다. 불밀링 후 분말을 건조(100°C, 3 h)하고, 체질(18 mesh)하여 1 mm이하의 조립분말을 얻었다. 조립분말을 일축 가압에 의해 성형체(치수는 6×15×40 mm<sup>3</sup>, 성형체의 상대밀도는 약 50%)를 제조하였다.

성형체를 흑연 도가니 안에 장입하고 소결과정에서의  $\text{Si}_3\text{N}_4$ 의 분해를 억제하기 위해 성형체의 주위를  $\text{Si}_3\text{N}_4$ 와 BN을 1:1(무게비)로 혼합한 분말로 패킹한후, 흑연을 발열체로 하는 저항로를 사용하여 소결(승온속도: 10°C/min, 0.1 MPa의 질소 분위기)하였다. 우선, 질화규소의 소결 치밀화도에 미치는 소결조제의 첨가량과 소결온도의 영향을 조사하기 위해, 소결조제의 양( $\text{Y}_2\text{O}_3/\text{Al}_2\text{O}_3$  몰비는 약 1.3으로 일정)을 변화시킨 4Y-3A와 8Y-6A조성의 조제를  $\alpha\text{-Si}_3\text{N}_4$  분말에 각각 첨가한 후, 1730°C~1800°C까지 소결온도를 변화시키며 2시간 소결하였다. 다음으로, 두 조성의 소결조제중에서 높은 치밀화도를 나타내었던 8Y-6A의 조성을 불밀링 처리에 의해 형상비를 변화시킨  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$ (w)를 각각 5~20 vol% 첨가한 후, 1800°C에서 2시간 소결하여, 소결 치밀화도에 미치는  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$ (w) 첨가량과 형상비의 영향을 조사하였다. 그리고, 5, 10 vol%의  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$ (w)를 첨가한 일부 성형체에 대해서는 1800°C에서 소결시간을 2~8시간까지 변화시켜, 소결시간에 따른 상대밀도와  $\text{Si}_3\text{N}_4$  결정립의 변화를 조사하였다. 일부 시편에 대해서는 소결전·후의 성형체와 소결체의 무게와 치수를 각각 측정하여, 무게감량(weight loss)과 선 수축률([(L<sub>G</sub>-L<sub>S</sub>)/L<sub>G</sub> × 100, L<sub>G</sub>: 성형체의 치수, L<sub>S</sub>: 소결체의 치수])을 구했다. 제조한 소결체는 다이아몬드 절삭기를 이용하여 절삭한 후, 평면 연삭·연리를 통해 사각시편(3×4×25 mm<sup>3</sup>)으로 제조하였다.

마지막으로, 액상소결시의  $\alpha\rightarrow\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$  상전이<sup>8)</sup>와 미세조직에 미치는  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$ (w)첨가의 영향을 조사하기 위해, 8Y-6A의 조성에 휘스커를 첨가하지 않은 성형체(원형시편; 직경 20 mm, 두께 10 mm)와 5 vol%의  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$ (w)를 첨가한 성형체를 소결온도를 1500°C~1700°C까지 변화시키며 2시간 동안 소결하였고, 소결후 시편 표면의 변질층(< 500  $\mu\text{m}$ )은 연마에 의해 제거하였다.

### 2.2. 물성측정 및 조직관찰

각 시편의 상대밀도는, 아로카메데스법을 이용하여 체적 밀도를 측정한 후 체적 밀도와 이론 밀도의 비로써 계산하였다. 단, 이론 밀도는 원료분말의 조성과 성분원소의 밀도로부터 혼합법칙(rule of mixture)을 이용하여 계산하였다. 각 시편의 강도는 만능시험기를 이용하여 KS L 1591의 굽힘강도 시험 방법에 의거하여 3점 굽힘강도(하부 지점 사이의 거리는 20 mm, 크로스헤드 속도는 0.5 mm/min)를 측정하였다.

시편의 괴괴인성( $K_{IC}$ )은 압자·압입법(indentation fracture method)을 사용하여 측정하였다. 압자·압입법은 압입면을 경면연마한 후 미세경도 시험기를 사용하여 98 N의 하중으로 비커스 압흔을 도입한 후 한 시편당 5회 측정한 값을 평균하여  $K_{IC}$ ( $K_{IC}=0.203(c/a)^{3/2}\cdot HV\cdot a^{1/2}$ ; c는 크랙

길이 평균의 반,  $a$ 는 암흔 대각선 길이 평균의 반, HV는 비커스 경도<sup>10</sup>를 측정하였다.

굽힘강도 시험후의 파단면,  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$  결정립의 직경과 길이( $\times 7,000$ 의 배율하에서 약 600개의 결정립을 측정) 그리고 비커스 암흔의 전파균열과  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$  결정립과의 상호작용을 주사전자현미경(SEM)으로 조사하였다.  $\text{Si}_3\text{N}_4$  결정립의 직경과 길이는 경면연마한 시편을 화학적에칭(HF+HNO<sub>3</sub>용액, 70°C, 30분)하여 관찰하였다. 마지막으로, 각 시편의 XRD분석(Cu K $\alpha$ , 주사범위: 10°~70°, 주사속도: 6°/min) 결과를 토대로, 소결온도에 따른  $\alpha\rightarrow\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$  상전이 분율<sup>10</sup>과 미세조직에 미치는  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4(w)$ 첨가의 영향을 조사하였다.

### 3. 결과 및 고찰

우선,  $\text{Si}_3\text{N}_4$  monolith 소결체의 상대밀도(Ds)에 미치는 소결조제 양과 소결온도의 영향을 조사하기 위해, 1730~1800°C에서 2시간 상압소결한 결과를 Fig. 1에 나타내었다. 상대밀도는 소결온도가 증가함에 따라 증가하였다. 소결조제의 조성이 4Y-3A인 경우에 비해 소결조제 양이 상대적으로 많은 8Y-6A의 경우가 모든 온도범위에서 약 10% 높은 상대밀도를 나타내었고, 1800°C의 고온에서는 상대밀도가 99.6%로 거의 치밀화되었다. 따라서, 높은 치밀화도를 나타내는 8Y-6A조성을 소결조제로 선택하여 1800°C, 2시간의 소결조건에서 상대밀도와 선수축율에 미치는  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4(w)$  첨가의 영향을 조사하여 Fig. 2에 나타내었다. 먼저, 상대밀도는  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4(w)$  첨가량과 함께 감소하는 경향을 나타내었고, 휘스커의 첨가량이 5~10 vol%까지는 완만하게 감소하였으나, 10 vol%이상

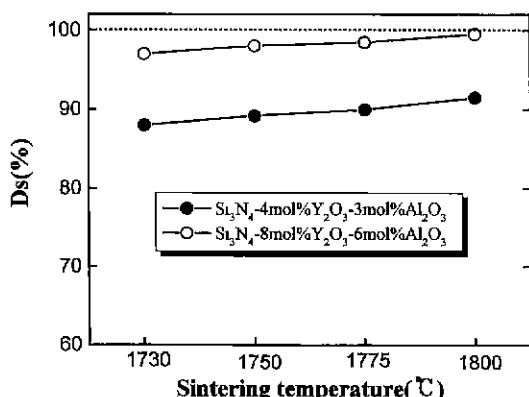


Fig. 1. Effect of amount of sintering aid on the relation between the relative density(Ds) and sintering temperature in  $\text{Si}_3\text{N}_4$  ceramics which were prepared by pressureless-sintering at 1730~1800°C for 2h.

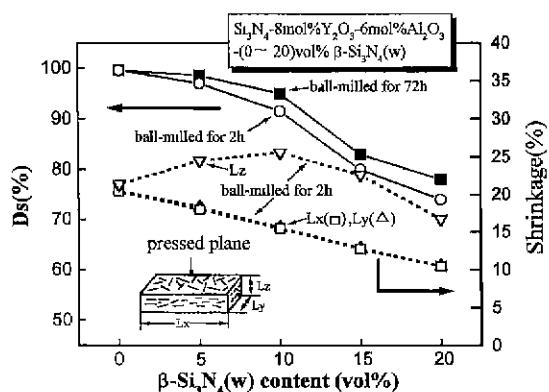


Fig. 2. Effect of  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$  whisker content on the relative density(Ds) and shrinkage of  $\text{Si}_3\text{N}_4$  ceramics which were prepared by pressureless-sintering at 1800°C for 2h.

에서 급격히 감소하였다. 휘스커 첨가에 따른 상대밀도의 감소는 액상소결과정에서 침상의 휘스커가 입자의 재배열을 방해하였기 때문으로 생각된다. 그리고, 휘스커의 불밀링 처리시간이 2시간의 경우에 비해 72시간의 경우가 약 2~5% 높은 상대밀도를 나타났는데, 이것은 장시간 불밀링 처리에 의해 휘스커의 형상비가 감소되어, 입자의 재배열을 방해하는 요인이 감소<sup>11</sup>하였기 때문이라고 생각된다. 5, 10 vol%의  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4(w)$ 를 첨가한 성형체를 1800°C에서 소결시간을 4, 6, 8시간으로 증가시킨 결과, 상대밀도는 소결시간의 증가와 더불어 약간 증가하는 경향을 보이기는 하였으나,  $\text{Si}_3\text{N}_4$ 의 분해에 의한 무게감량이 증가하여 100% 치밀화되지는 못했다. 한편, 선수축율은 그림에 나타낸 바와 같이 3방향(Lx, Ly, Lz)의 수축율을 측정하였는데, 복잡성을 피하기 위해 2시간 불밀한 휘스커를 첨가한 시편의 결과만을 나타내었다. 우선,  $\text{Si}_3\text{N}_4$  monolith의 수축율은 3방향 모두에서 약 20~22%로, 거의 비슷하였다. 그러나,  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4(w)$ 를 첨가한 경우는 분말 성형시의 가압방향, 즉, 시편의 두께방향(Lz)으로는 비교적 높은 선수축률을 보이나, 가압방향에 수직한 방향, 즉, 시편의 너비방향(Ly)과 길이방향(Lx)에서는 모두 낮게 나타났다. 이와 같은 선수축률의 차이는 혼합분말내의  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4(w)$ 의 배향은 3차원적으로 무질서하지만, 프레스 성형(일축가압 성형, 압축비는 약 4)시,  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4(w)$ 가 침상이기 때문에 가압방향에 대하여 수직한 방향으로 약간 배향되었기 때문으로 생각된다. 한편, 1800°C, 2시간의 소결 조건에서  $\alpha\text{-Si}_3\text{N}_4$ 는  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4(w)$ 의 첨가량과 무관하게  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$ 로 100% 상전이가 완료되었음을 XRD분석에 의해 확인하였다.

Fig. 3은 상압소결체의 파괴인성( $K_{IC}$ )과 굽힘강도(FS)에 미치는  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4(w)$  첨가량의 영향을 나타내었다. 먼저, 파

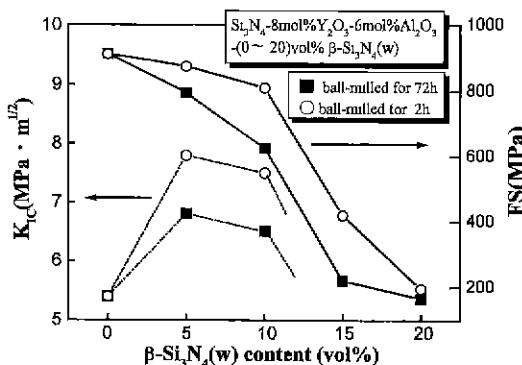


Fig. 3. Effect of  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$  whisker content on fracture toughness ( $K_{IC}$ ) and flexural strength(FS) of  $\text{Si}_3\text{N}_4$  ceramics which were prepared by pressureless-sintering at  $1800^{\circ}\text{C}$  for 2h.

괴인성은  $\text{Si}_3\text{N}_4$  monolith의 약  $5.4 \text{ MPa} \cdot \text{m}^{1/2}$ 에 비해  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4(\text{w})$ 를 첨가한 시료에서 크게 나타났다. 예를 들어, 72시간 볼밀링 처리한 휘스커를 5 vol%와 10 vol% 첨가한 경우는 각각 약  $6.8 \text{ MPa} \cdot \text{m}^{1/2}$ 과  $6.5 \text{ MPa} \cdot \text{m}^{1/2}$ 로 증가하였고, 2시간 볼밀링 처리한 경우에는 각각 약  $7.8 \text{ MPa} \cdot \text{m}^{1/2}$ 과  $7.5 \text{ MPa} \cdot \text{m}^{1/2}$ 로 증가하였다. 즉,  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4(\text{w})$ 의 볼밀링 처리시간이 짧은 경우에  $K_{IC}$ 값이 높게 나타났고, 10 vol% 첨가에 비해 5 vol%를 첨가한 경우에서  $K_{IC}$ 가 약간 높게 나타났다. 그러나, 15, 20 vol%의  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4(\text{w})$ 를 첨가한 시료의 경우는 잔류기공이 많았기 때문에 압자압입법으로는 정확한  $K_{IC}$ 치를 측정할 수 없었다. 한편, 굽힘강도는  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4(\text{w})$  첨가량과 함께 감소하였으나, 대략 5~10 vol%의  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4(\text{w})$ 의 첨가량까지는 비교적 완만하게 감소하여 상대밀도의 결과와 비슷한 경향을 보였고,  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4(\text{w})$ 의 볼밀링 처리시간이 짧은 경우가 높게 나타났다. 10 vol% 이상의  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4(\text{w})$ 를 첨가하였을 때에 굽힘강도가 급격히 감소하는 것은 전술한

바와 같이 잔류기공이 많고 치밀화되지 못했기 때문이라고 생각된다.

다음에, 각 시편의 경면연마면을 화학부식 후 SEM으로 관찰한 미세구조를 Fig. 4에 나타내었다.  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4(\text{w})$ 를 첨가하지 않은  $\text{Si}_3\text{N}_4$  monolith의 조직은 미세한 결정립으로 구성되어 있으나,  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4(\text{w})$ 를 첨가한 경우에는 미세한 결정립 내에 조대한 침상의 결정립들이 분산되어져 있음을 알 수 있다. 그리고  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4(\text{w})$ 의 첨가량이 증가할수록 조대한 침상의 결정립들이 더 많이 분포되어 있는 것을 알 수 있다. 또한, 조대한 결정립은 열간기압소결법에 의해 제조한 경우에서와 같이 첨가된 휘스커가 종자(seed)로 작용하여 용해·재석출시 형성된 core-rim 구조<sup>2,12)</sup>를 뚜렷히 나타내고 있다.

Fig. 5는 상압소결 시편에서 비커스·압자에 의해 도입한 전파균열에 대하여 균열편향각의 누적빈도를 측정한 결과를 나타내었다.  $\text{Si}_3\text{N}_4$  monolith보다는  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4(\text{w})$ 를 첨가한 경우에 균열편향각의 각도가 크다는 것을 알 수 있다. 또한,  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4(\text{w})$ 를 첨가한 시편간에는 휘스커의 첨가량이 많을수록, 볼밀링시간이 짧을수록 균열편향각이 증대하였다. Fig. 6은 상압소결에 의해 제조된  $\text{Si}_3\text{N}_4$  monolith와 자체 장인화  $\text{Si}_3\text{N}_4$ 의 표면면을 SEM으로 관찰한 결과를 나타내었다.  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4(\text{w})$ 를 첨가한 시편에서 조대한 결정립의 입내파괴와 입계파괴가 관찰되었고 pull-out도 관찰할 수 있었다. 그러나, 미세균열은 관찰되지 않았다. 따라서, 자체 장인화  $\text{Si}_3\text{N}_4$ 의 파괴인성이 향상된 것은 조대한 침상  $\text{Si}_3\text{N}_4$  결정립에 의한 균열편향 효과, pull-out, 가교 등이 활발히 일어난 결과로 생각된다.

다음으로, 본 자체 장인화  $\text{Si}_3\text{N}_4$  세라믹의 파괴인성 ( $K_{IC}$ )에 영향을 미치는 소결체의 상대밀도와  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$  결정립의 형상비에 대하여 고찰한다. 먼저, 상대밀도에 대해서는, 일반적으로 잘 알려진 바와 같이,  $D_s$ 가 낮아질수록 즉, 기공율이 증가할수록  $K_{IC}$ 는 감소한다. 따라서, 5 vol%  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4(\text{w})$ 를 첨가한 경우가 10 vol%  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4(\text{w})$ 를 첨



Fig. 4. Scanning electron micrographs of etched surfaces of  $\text{Si}_3\text{N}_4$  monolith and self-reinforced  $\text{Si}_3\text{N}_4$  ceramics which were prepared by pressureless-sintering at  $1800^{\circ}\text{C}$  for 2h. (a) monolith, (b) 5vol%  $\text{Si}_3\text{N}_4$  whiskers(ball-milled for 2h), (c) 10vol%  $\text{Si}_3\text{N}_4$  whiskers(ball-milled for 2h) C and R in figures denote the core and rim region of large acicular  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$  grain, respectively.

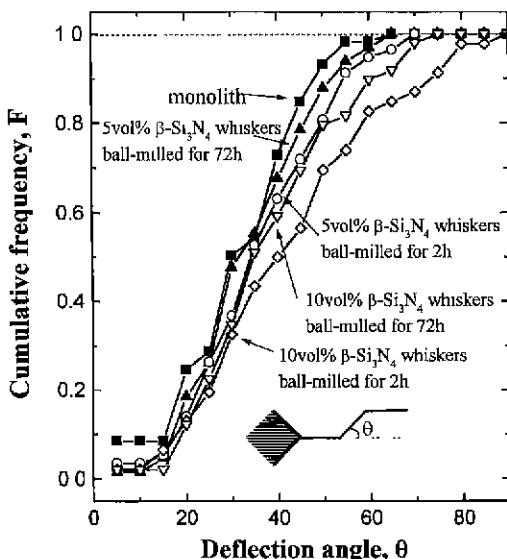


Fig. 5. Distribution of cumulative frequency of deflection angle of crack segment to main crack direction for  $\text{Si}_3\text{N}_4$  monolith and self-reinforced  $\text{Si}_3\text{N}_4$  ceramics which were prepared by pressure-less-sintering at  $1800^{\circ}\text{C}$  for 2h.

가한 경우에 비해  $K_{IC}$ 가 높게 나타난 것은 조대한 침상의  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$  결정립에 의한  $K_{IC}$ 의 증가보다는 응력집중원으로 작용하는 잔류 미세기공의 증가에 따른  $K_{IC}$ 의 감소가 더 커졌기 때문으로 생각된다. 한편, 전술한 바와 같이 15, 20 vol%의  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4(w)$ 를 첨가한 경우는 잔류 미세기공이 많아 압자압입법으로는 정확한  $K_{IC}$ 값을 측정할 수가 없었으나, 다른  $K_{IC}$ 측정법을 사용하여 측정한다 하더라도 낮은 값을 나타낼 것으로 판단되었다.

한편, 파괴인성에 미치는  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$  결정립의 형상비의 영향을 조사하기 위해, 2차원 단면 조직내에서의 결보기 길이와 직경을 측정하여 계산한 2차원 형상비(2D)와 이

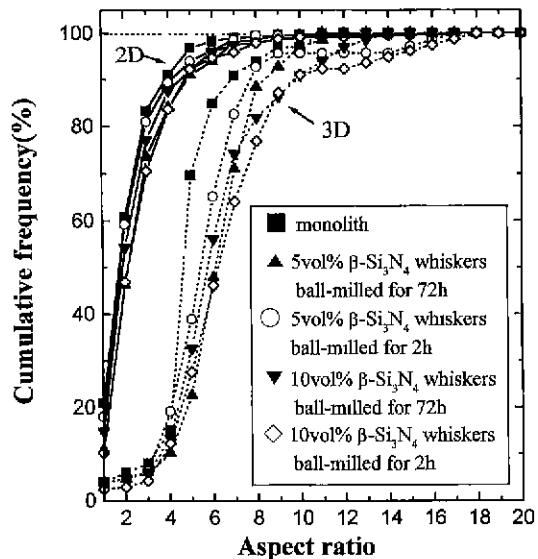


Fig. 7. Distribution of cumulative frequency for aspect ratio of  $\text{Si}_3\text{N}_4$  grains for  $\text{Si}_3\text{N}_4$  monolith and self-reinforced  $\text{Si}_3\text{N}_4$  ceramics which were prepared by pressure-less-sintering at  $1800^{\circ}\text{C}$  for 2h. 2D(solid line) and 3D(dotted line) denote 2 dimensional aspect ratio and 3 dimensional aspect ratio, respectively.

2차원 형상비로부터 추정<sup>13</sup>한 3차원 형상비(3D)의 누적분포를 측정한 결과를 Fig. 7에 나타내었다. 형상비는  $\text{Si}_3\text{N}_4$  monolith보다는 자체 강인화  $\text{Si}_3\text{N}_4$ 에서 높게 나타났다. 이 결과를 전술한 Fig. 3의 결과와 비교하면, 형상비가 작은  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$  결정립들로 이루어진  $\text{Si}_3\text{N}_4$  monolith에서  $K_{IC}$ 값이 낮게 나타난 반면, 형상비가 큰  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$  결정립들이 분산된 자체 강인화  $\text{Si}_3\text{N}_4$ 에서 높게 나타나, 형상비와  $K_{IC}$ 간의 상관관계는 일반적인 견해와 일치하였다. 휴스커의 불밀링 처리시간이 긴 경우가 짧은 경우에 비해 약 2~5% 높은 상대밀도를 나타났음에도 불구하고, 약간 낮은  $K_{IC}$ 를 나타낸 것은, 장시간 불밀링 처리에 의



Fig. 6. Scanning electron micrographs of fracture surfaces of each specimen which was prepared by pressureless-sintering at  $1800^{\circ}\text{C}$  for 2h. P in figure denotes pull-out. (a) monolith, (b) 5vol%  $\text{Si}_3\text{N}_4$  whiskers(ball-milled for 2h) and (c) 10vol%  $\text{Si}_3\text{N}_4$  whiskers(ball-milled for 2h).

해 휘스커의 형상비가 감소되어, 잔류 미세기공의 감소에 따른  $K_{IC}$ 의 증가요인보다는 낮은 형상비에 따른  $K_{IC}$ 의 감소요인이 더 커졌기 때문으로 생각된다.

한편,  $\text{Si}_3\text{N}_4$  세라믹의 강도는 파괴인성과 조직적결합에 의존하므로,<sup>14)</sup> 자체 강인화  $\text{Si}_3\text{N}_4$  세라믹의 파단면을 SEM으로 조사한 결과, 조제한 침상결정법으로 구성된 응집체가 관찰되었다. 따라서,  $\text{Si}_3\text{N}_4$  monolith에 비해 자체 강인화  $\text{Si}_3\text{N}_4$  세라믹에서 파괴인성이 증가하였음에도 불구하고 낮은 강도를 나타낸 것은 파괴원으로 작용하는 조직적결합이 증대하였기 때문으로 생각된다.

마지막으로, 상압소결시  $\alpha \rightarrow \beta\text{-Si}_3\text{N}_4$  상전이와 미세조직에 미치는  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4(w)$ 첨가의 영향에 대해서 고찰한다. 먼저, 본 실험에서 첨가한  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4(w)$ 가 핵으로 작용하여  $\alpha \rightarrow \beta\text{-Si}_3\text{N}_4$  상전이를 촉진시키는 효과가 있는지를 조사하기 위해, 소결온도( $1500^{\circ}\text{C} \sim 1700^{\circ}\text{C}$ , 소결시간은 2시간)에 따른 잔류  $\alpha\text{-Si}_3\text{N}_4$ 의 양을 조사한 결과를 Fig. 8에 나타내었다. 모든 소결온도 범위에서  $\text{Si}_3\text{N}_4$  monolith에 비해  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4(w)$ 를 첨가한 경우가 잔류  $\alpha\text{-Si}_3\text{N}_4$ 의 분율이 감소함을 알 수 있다. 그리고,  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4(w)$ 를 첨가한 시편간에서는 불밀링 처리시간이 72시간인 경우가 잔류  $\alpha$ 상의 분율이 감소하였다. 한편,  $1500^{\circ}\text{C}$ 의 소결온도에 도달될 때 까지의 승온과정중  $\alpha \rightarrow \beta$ 상으로의 상전이는 극히 적으므로,<sup>15)</sup> 소결전과 소결후의  $\beta$ 상의 분율로 부터,  $1500^{\circ}\text{C}$ 에서의 상전이 속도상수<sup>16)</sup>를 계약적으로 계산한 결과,  $\text{Si}_3\text{N}_4$  monolith에서는 약  $1.2 \times 10^{-4} \text{ min}^{-1}$ ,  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4(w)$ 를 첨가한 시편간에서는 불밀링 처리시간이 2시간, 72시간인 경우에 서 각각  $5.6 \times 10^{-4} \text{ min}^{-1}$ ,  $6.8 \times 10^{-4} \text{ min}^{-1}$ 으로 나타났다. 따라서,  $\text{Si}_3\text{N}_4$  monolith에 비해  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4(w)$ 를 첨가한 경우에서,  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4(w)$ 를 첨가한 시편간에는 불밀

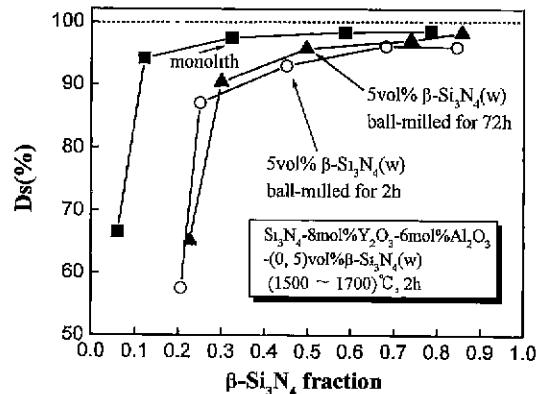


Fig. 9. Effect of  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$  whiskers on the relation between  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$  fraction and relative density(Ds).

링 처리시간이 2시간에 비해 72시간인 경우에서 각각 속도상수가 증가함을 알 수 있었다. 이러한 자체 강인화  $\text{Si}_3\text{N}_4$  세라믹에서의 속도상수의 증가는 이미  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$ 핵이 존재하기 때문에 새로운 핵을 형성하는데 필요한 에너지, 즉 활성화에너지가 감소되기 때문으로 생각되었다.

다음으로, 소결온도에 따른 상대밀도와  $\beta$ 상의 분율과의 관계를 Fig. 9에 나타낸다. 모든 시편에서 초기에 치밀화가 충분히 진행되고  $\beta$ 상으로의 상전이가 일어나는 것을 알 수 있다. 그리고 상대밀도와  $\beta$ 상 분율의 관계곡선은  $\text{Si}_3\text{N}_4$  monolith에서는 고밀도-저  $\beta$ 상 분율쪽에 위치하나,  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4(w)$ 를 첨가한 경우에는 저밀도-고  $\beta$ 상 분율쪽으로 이동하는 것을 알 수 있다. 다음에 상전이와 미세조직과의 상관성을 조사하기 위해 파단면 조직을 SEM으로 관찰한 결과를 Fig. 10에 나타내었다. 모든 소결온도에서 주로 입개파괴가 일어나고 있음을 알 수 있다.  $1500^{\circ}\text{C}$ 에서의 조직은 액상형성 및 입자재배열의 단계를 보이고 있으며, 액상이 입자간에 가교를 형성하고 있는 것을 알 수 있다.  $1600^{\circ}\text{C}$ 와  $1700^{\circ}\text{C}$ 의 조직은 각각 용해·재석출에 의한 상전이의 초기와 후기단계를 보이고 있다. 특히,  $1600^{\circ}\text{C}$ 의 조직의 경우  $\text{Si}_3\text{N}_4$  monolith에서는 침상으로 빌랄하는 결정법이 극히 적으나,  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4(w)$ 를 첨가한 자체 강인화 세라믹에서는 이미 조제하게 성장하기 시작하는  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$  결정법이 관찰된다. 이상의 소결온도에 따른 상전이분율과 상대밀도의 변화와 미세조직 관찰 결과를 토대로,  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4(w)$ 를 첨가한 자체 강인화 세라믹의 액상소결과정시의 조직변화를 Fig. 11에 모식도로 나타내었다.

마지막으로, 본 실험의 결과를 종합하면, 자체 강인화  $\text{Si}_3\text{N}_4$  세라믹의 상압소결시 치밀화에 미치는 제조조건을 검토하여, 불밀링 처리시간이 2시간인  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4(w)$ 를 소량(5 vol%) 첨가하여  $1800^{\circ}\text{C}$ 에서 2시간 소결한 경우에는

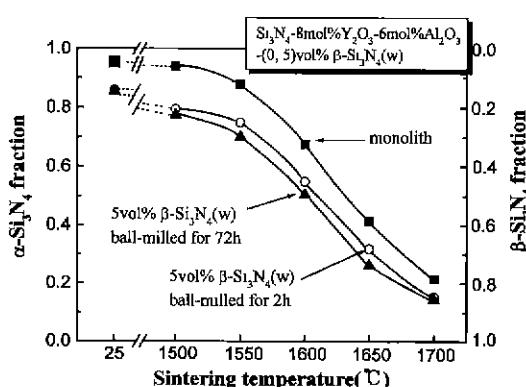


Fig. 8. Variations of  $\alpha\text{-Si}_3\text{N}_4$  fraction as a function of sintering temperature for  $\text{Si}_3\text{N}_4$  monolith and self-reinforced  $\text{Si}_3\text{N}_4$  ceramics which were prepared by pressureless-sintering at  $1500\text{--}1700^{\circ}\text{C}$  for 2h.

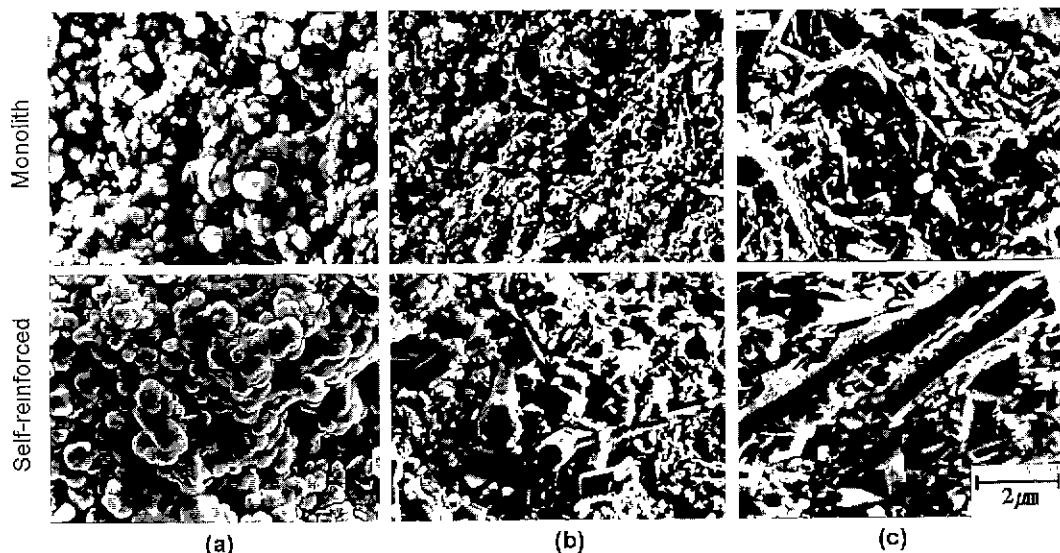


Fig. 10. Variations of fracture surface with sintering temperature in  $\text{Si}_3\text{N}_4$  monolith and self-reinforced  $\text{Si}_3\text{N}_4$  ceramics which were prepared by pressureless-sintering for 2h at the temperature of (a) 1500°C, (b) 1600°C and (c) 1700°C.

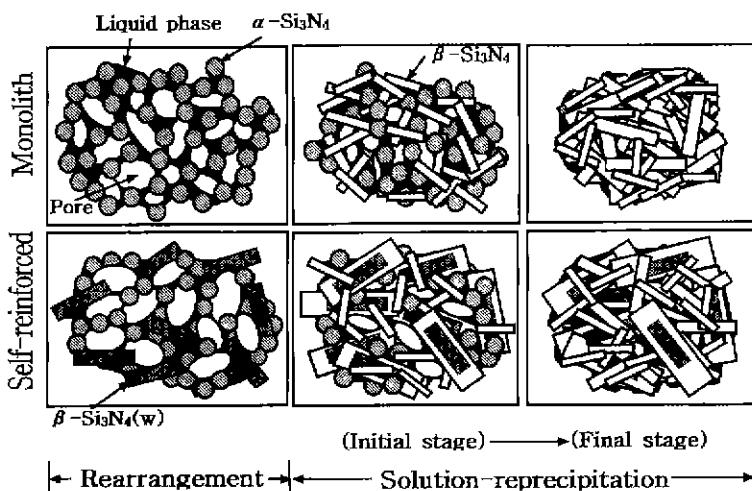


Fig. 11. Schematic diagram of the liquid-phase sintering stages in  $\text{Si}_3\text{N}_4$  monolith and self-reinforced  $\text{Si}_3\text{N}_4$  ceramic.

상대밀도가 약 98%로 비교적 치밀한 소결체를 얻을 수 있었으며,  $\text{Si}_3\text{N}_4$  monolith에 비해 고인성을 나타내었다. 그러나, 전술한 바와 같이 1800°C에서 장시간 소결하여도 치밀화도는 크게 증가하지 않았다. 이것은 상압소결 시  $\text{Si}_3\text{N}_4$ 의 분해가 1800°C부근에서 시작되기 때문으로 생각된다. 따라서 상압소결 후 재차 열간정수압 소결(HIP)법을 이용하거나, 질소분압을 높인 가스압 소결법을 이용하여 보다 고온에서 소결하면 이론밀도에 가깝게 치밀화시킬 수 있을 것으로 기대되었으며, 이 점에 대해서는 추후 검토할 예정이다.

#### 4. 결 론

미세한 침상의 결정입자로 구성된 조직내에 조태한  $\beta$ - $\text{Si}_3\text{N}_4$ (w)를 분산시킨 자체 강인화  $\text{Si}_3\text{N}_4$ 의 상압소결시 치밀화에 미치는 제조조건을 검토하였고, 최적 조건하에서 제조한 소결체의 기계적 성질과 미세조직을 조사하여 다음과 같은 결론을 얻었다.

1. 자체 강인화  $\text{Si}_3\text{N}_4$  세라믹스의 상압소결 치밀화도는, 소결조제의 첨가량이 많을수록,  $\beta$ - $\text{Si}_3\text{N}_4$ (w)의 첨가량이 적을수록,  $\beta$ - $\text{Si}_3\text{N}_4$ (w)의 형상비가 작을수록 향상되었다.

소결조제로서 8 mol%  $\text{Y}_2\text{O}_3$ 와 6 mol%  $\text{Al}_2\text{O}_3$ 을 사용하고, 2시간 불밀링한  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4(\text{w})$ 를 5 vol% 첨가하여 1800°C에서 2시간 소결한 경우, 상대밀도는 약 98%로 높은 치밀화도를 나타내었다.

2. 자체 강인화  $\text{Si}_3\text{N}_4$  세라믹스의 파괴인성은  $\text{Si}_3\text{N}_4$  monolith의 5.4 MPa·m<sup>1/2</sup>에 비해 7.8 MPa·m<sup>1/2</sup>로 비교적 높은 값을 보였다. 그리고 파괴인성의 향상은 자체 강인화  $\text{Si}_3\text{N}_4$  세라믹스 조직내의 조대한 침상  $\text{Si}_3\text{N}_4$  결정에 의한 균열편향, pull-out, 가교 등에 기인한 것으로 생각된다.

3.  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4(\text{w})$ 는  $\alpha \rightarrow \beta\text{-Si}_3\text{N}_4$  상전이시 핵으로 작용하여 상전이를 촉진시키는 효과가 있으며, 촉진효과는 핵의 수가 많을수록 증대되었다. 이는  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4(\text{w})$ 첨가에 의해 새로운 핵을 형성하는데 필요한 에너지, 즉 상전과정의 활성화에너지가 감소하였기 때문으로 생각되었다.

### 감사의 글

본 연구는 한국과학재단 핵심전문 연구비(971-0801-009-1)지원으로 수행된 연구결과의 일부이며, 재단의 지원에 감사드립니다.

### REFERENCES

1. 김완중, 이영규, 장병국, 조원승, 최상욱, "Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>의 기계적 성질과 미세조직에 미치는  $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$  휘스커 첨가의 영향," 한국요업학회 춘계총회, 초청·특별강연, 연구발표회 초록집, 114 (1998).
2. 김완중, 이영규, 조원승, 최상욱, "미세구조 제어에 의해 제조한 자체 강인화 질화구소 세라믹의 기계적 성질과 미세조직," 요업학회지, 36(4), 432-443 (1999).
3. K. T. Faber and A. G. Evans, "Crack Deflection Process - Theory," *Acta Metall.*, 31(4), 565-576 (1983).
4. P. F. Becher, E. R. Fuller and P. Angelini, "Matrix-Grain-Bridging Contributions to the Toughness of Whiskers-Reinforced Ceramics," *J. Am. Ceram. Soc.*, 74(9) 2131-2135 (1991).
5. M. D. Thouless and A. G. Evans, "Effects of Pull-Out on the Mechanical Properties of Ceramic-Matrix Composites," *Acta Metall.*, 36(3) 517-533 (1988)
6. K. Hirao, K. Watari, M. E. Brito, M. Tonyama and S. Kanazaki, "High Thermal Conductivity in Silicon Nitride with Anisotropic Microstructure," *J. Am. Ceram. Soc.*, 79(9) 2485-2488 (1996).
7. T. Ohji, K. Hirao and S. Kazaki, "Fracture Resistance Behavior of Highly Anisotropic Silicon Nitride," *J. Am. Ceram. Soc.*, 78(11) 3215-3218 (1995).
8. D. R. Messier, F. L. Filey and R. J. Brook, "The  $\alpha/\beta$  Silicon Nitride Phase Transformation," *J. Mater. Sci.*, 13, 1199-1205 (1978).
9. K. Niitohara, "Indentation Microfracture of Ceramics," *Ceramics*, 20(1), 12-18 (1985).
10. C. P. Gazzara and D. R. Messier, "Determination of Phase Content of Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> by X-ray Diffraction Analysis," *Am. Ceram. Soc. Bull.*, 56(9), 777-780 (1977).
11. W. S. Cho and K. Hayashi, "Effect of Uni-Directional Orientation of SiC Whiskers on Pressureless-Sintering Densification of SiC Whisker/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> Ceramics Composite," *J. Jpn. Soc. Powder & Powder Metallurgy*, 40(1) 16-19 (1993).
12. N. Hirosaki, M. Tanimura, Y. Akimune and M. Mimoto, "TEM Analysis of Core-Rim Structure in  $\beta$ -Silicon Nitride Ceramics," *J. Ceram. Soc. Jpn.*, 102(9), 875-879 (1994).
13. G. Wötting, B. Kanka and G. Ziegler, "Microstructural Development, Microstructural Characterization and Relation to Mechanical Properties of Dense Silicon Nitride" : pp. 83-96 in Nonoxide Technical and Engineering Ceramics. Ed. by S. Hampshire, Elsvier Applied Science, London, 1986.
14. Y. Yanaba, W. S. Cho and K. Hayashi, "Observation of Fracture Source in High Strength Silicon Nitride-Based Ceramics," *J. Jpn. Inst. Metals*, 57(11), 1352-1359 (1993).
15. W. S. Cho and K. Hayashi, "Effect of Kinds of Sintering Aids of Rare Earth Oxides on Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> Grain size and Fracture Toughness of SiC Whisker/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> Composite Ceramics," *J. Ceram. Soc. Jpn.*, 100(7) 936-940 (1992)
16. L. J. Bowen, R. J. Weston, T. G. Carruthers and R. J. Brook, "Hot-pressing and the  $\alpha/\beta$  Phase Transformation in Silicon Nitride," *J. Mater. Sci.*, 13, 341-350 (1978).